

首 页 成果 | 机构 | 登记 | 资讯 | 政策 | 统计 | 会展 | 我要技术 | 项目招商 | 广泛合作

科技频道 节能减排 | 海洋技术 | 环境保护 | 新药研发 | 新能源 | 新材料 | 现代农业 | 生物技术 | 军民两用 | IT技术

国科社区 博客 | 技术成果 | 学术论文 | 行业观察 | 科研心得 | 资料共享 | 时事评论 | 专题聚焦 | 国科论坛



国防科工 | 航空航天 | 计算机与网络 | 汽车与车辆 | 船艇 | 新材料与新工艺 | 能源与环保 | 光机电 | 通信
专题资讯

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 选择外延法制造源漏在绝缘体上的场效应晶体管

选择外延法制造源漏在绝缘体上的场效应晶体管

关 键 词: 绝缘体 源漏 场效应晶体管 选择外延法

所属年份: 2003

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所

成果摘要:

该发明专利是一种源漏在绝缘体上的场效应晶体管(MOSFET)的制造方法，属于微电子技术领域。其特征为：采用选择外延法在常规SOIMOSTET器件的沟道下方埋氧中开一个窗口，使器件的沟道和硅衬底相连接，达到顶层硅和埋氧的刻蚀；在沟道区域选择外延单晶硅；化学机械抛光平坦化；常规CMOS工艺完成器件的制造等工艺步骤。采用该方法制造的源漏的绝缘体上的晶体，具有埋氧和体硅之间界面陡峭，缺陷少等优点，保证了器件的性能，在深亚微米集成电路的制造中有一定的应用前景。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- [塔北地区高精度卫星遥感数据处理](#)
- [综合遥感技术在公路深部地质...](#)
- [轻型高稳定度干涉成像光谱仪](#)
- [智能化多用途无人机对地观测技术](#)
- [稳态大视场偏振干涉成像光谱仪](#)
- [2001年土地利用动态遥感监测](#)
- [新疆特克斯河恰甫其海综合利...](#)
- [用气象卫星资料反演蒸散](#)
- [天水陇南滑坡泥石流遥感分析](#)
- [综合机载红外遥感测量系统及...](#)

成果交流

推荐成果

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| · 容错控制系统综合可信性分析... | 04-23 |
| · 基于MEMS的微型高度计和微型... | 04-23 |
| · 基于MEMS的载体测控系统及其... | 04-23 |
| · 微机械惯性仪表 | 04-23 |
| · 自适应预估控制在大型分散控... | 04-23 |
| · 300MW燃煤机组非线性动态模型... | 04-23 |
| · 先进控制策略在大型火电机组... | 04-23 |
| · 自动检测系统化技术的研究与应用 | 04-23 |
| · 机械产品可靠性分析--故障模... | 04-23 |

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号